

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 多学科研究中心

一种硅纳米柱阵列光电池的选择性栅极及其制作方法

文献类型: 专利

作者 刘静 ; 伊福廷

发表日期 2013-07-22

专利号 CN103390657A

公开日期 2013-11-13

源URL [<http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/211130>]

专题 高能物理研究所_多学科研究中心

作者单位 中国科学院高能物理研究所

推荐引用方式 刘静,伊福廷. 一种硅纳米柱阵列光电池的选择性栅极及其制作方法. CN103390657A. 2013-07-22.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [高能物理研究所](#)

浏览

6

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号

0931-8270076 [发送邮件](#)